

1	ФИО	Итальянцев Александр Георгиевич		
2	Ученая степень	Доктор физико-математических наук, специальность 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро - и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах», диплом серия ДДН № 011402, 2009 г.		
3	Ученое звание	-		
4	Основное место работы	АО "Научно-исследовательский институт Молекулярной Электроники", Россия, Зеленоград (АО НИИМЭ)		
5	Должность	Начальник отдела		
6	Рабочий телефон	+7 (495) 229-72-76		
7	Электронная почта	aitalyantsev@niime.ru		
8	Список основных публикаций оппонента в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15-ти)	П. С. Захаров А. Г. Итальянцев.	Эффект переключения электрической проводимости в структурах металл-диэлектрик-металл на основе нестехиометрического оксида кремния.	ТРУДЫ МФТИ. — 2015. — Том 7, № 2 стр. 113-118
		П. С. Захаров А. Г. Итальянцев.	Математическое моделирование распределения температуры в ячейке резистивной памяти на основе оксида кремния	Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2015. № 4 (160). С. 69-72.
		П. С. Захаров А. Г. Итальянцев.	Эффект резистивного переключения в структурах памяти на основе оксида кремния	Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2015. № 3 (159). С. 5-10
		Итальянцев А., Шульга Ю., Чашин Д., Шарпинский О.	Современные изделия пьезoeлектроники: новые возможности	Электроника: Наука, технология, бизнес. 2015. № 5 (145). С. 96-103.
		Четвериков В.А., Итальянцев А.Г., Баранов Г.В.	Твердофазный тримминг при формировании структур кремниевой микроэлектроники	Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2016. № 4 (164). С. 20-24.
		П. С. Захаров А. Г. Итальянцев.	Модель эффекта переключения электрической проводимости в структурах резистивной памяти на основе нестехиометрического оксида кремния	Известия высших учебных заведений. Электроника. 2016. Т. 21. № 4. С. 309-315.
		Макаров М.Э., Итальянцев А.Г., Барабаненков М.Ю.	Частотное ограничение интегрального фазового модулятора на основе кремниевое р-і-п	Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2017. Т. 1. № 1 (1). С. 602-606.

			диода в субнаносекундном импульсном режиме	
		Баранов Г.В., Итальянцев А.Г., Песков Ш.Г.	Особенности перераспределения атомов as в si при ионной имплантации структур sio2-si	Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2017. № 2 (166). С. 4-10.

Генеральный директор АО «НИИМЭ»,
Академик РАН, д.т.н, профессор

05.09.2018



Г.Я.Красников

Handwritten signature